

MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

surface 12a and is a surface on a side that is electrostatically chucked to a mask stage of an exposure device. The first main surface 12a includes a first region 20a located on the center side and a second region 20b located outside the first region 20a. The second main surface 12b includes a third region 20c located on the center side and a fourth region 20d located outside the third region 20c. An angle α formed by the plane having the least squares of the first region 20a and the plane having the least squares of the third region 20c is less than 1.2° . The PV values of the surfaces of the second region 20b and the fourth region 20d are 400 nm or less.

(57) 要約: 露光装置のマスキングステージにセットされた後の表面形状を正確に算出することのできるマスクブランク用基板を提供する。マスクブランク用基板10は、転写パターンが形成される側の面である第1の主表面12aと、第1の主表面12aに対向し、露光装置のマスキングステージに静電チャックされる側の面である第2の主表面12bとを備える。第1の主表面12aは、中心側に位置する第1の領域20aと、第1の領域20aの外側に位置する第2の領域20bを備える。第2の主表面12bは、中心側に位置する第3の領域20cと、第3の領域20cの外側に位置する第4の領域20dを備える。第1の領域20aの最小二乗平面と、第3の領域20cの最小二乗平面とのなす角度 α が、 1.2° 未満である。第2の領域20b及び第4の領域20dの表面のPV値が、400nm以下である。